## 物理学报 Acta Physica Sinica



Institute of Physics, CAS

#### 离子辐照和氧化对IG-110核级石墨中的点缺陷的影响

李明阳 张雷敏 吕沙沙 李正操

Effects of ion irradiation and oxidation on point defects in IG-110 nuclear grade graphite Li Ming-Yang Zhang Lei-Min Lv Shasha Li Zheng-Cao 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 68, 128102 (2019) DOI: 10.7498/aps.68.20190371 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.68.20190371

当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

#### 您可能感兴趣的其他文章

#### Articles you may be interested in

质子束辐照单层石墨烯的损伤效应

Damage effects of proton beam irradiation on single layer graphene 物理学报. 2017, 66(2): 026103 https://doi.org/10.7498/aps.66.026103

点缺陷浓度对非化学计量比L12型结构的A13Sc弹性性能的影响 Effects of point defect concentrations on elastic properties of off-stoichiometric L12-type A13Sc 物理学报. 2016, 65(7): 076101 https://doi.org/10.7498/aps.65.076101

非晶合金的离子辐照效应 Ion irradiation of metallic glasses 物理学报. 2017, 66(17): 178101 https://doi.org/10.7498/aps.66.178101

氢离子辐照纯钒中形成的位错环

Characterization of dislocation loops in hydrogen-ion irradiated vanadium 物理学报. 2016, 65(6): 066102 https://doi.org/10.7498/aps.65.066102

#### 高能重离子辐照的低活化钢硬化效应

Hardening of reduced activation ferritic/martensitic steels under the irradiation of high-energy heavy-ion 物理学报. 2017, 66(11): 112501 https://doi.org/10.7498/aps.66.112501

关于压水堆产武器级钚的模拟计算

Simulation calculation of weapon-grade plutonium production in pressurized water reactor 物理学报. 2017, 66(8): 082801 https://doi.org/10.7498/aps.66.082801

# 离子辐照和氧化对 IG-110 核级石墨中的 点缺陷的影响\*

李明阳1) 张雷敏2) 吕沙沙3)† 李正操4)‡

1) (清华大学工程物理系,北京 100084) 2) (中核北方核燃料元件有限公司,包头 014035) 3) (北京师范大学核科学与工程学院,北京 100875) 4) (清华大学材料学院,先进材料教育部重点实验室,北京 100084) (2019年3月15日收到; 2019年4月12日收到修改稿)

核级石墨是球床模块式高温气冷堆 (HTR-PM) 中的一种关键材料, 在堆内用作燃料元件基体材料、结 构材料和中子反射层材料.研究核级石墨辐照和氧化行为下的缺陷演化对反应堆安全具有重要意义.本文对 IG-110 石墨样品进行了一系列包含不同顺序和不同条件的离子辐照和氧化的实验, 分为仅辐照、仅氧化、辐 照后氧化、氧化后辐照,通过观察其结构、形貌、石墨化程度和点缺陷的演化,研究离子辐照和氧化对 IG-110 核级石墨中点缺陷的影响. 拉曼光谱表明, 随辐照剂量的增大, 拉曼峰强比 I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>先增大后减小, 说明离 子辐照使石墨中产生了点缺陷,且点缺陷在辐照剂量增大时进一步发生演化;氧化后石墨化程度增大,说明 高温下的退火效应使点缺陷发生复合,因此氧化之后点缺陷数量减少.氧化后辐照样品的点缺陷含量低于仅 辐照样品,辐照后氧化样品的点缺陷含量高于仅氧化样品.正电子湮灭多普勒展宽揭示了离子辐照后石墨中 仅有点缺陷,而氧化使点缺陷部分回复,离子辐照和氧化对石墨中点缺陷的演化产生相反的影响,即离子辐 照使平均 S 参数增大, 平均 W 参数减小, 而氧化使平均 S 参数减小, 平均 W 参数增大. 对于辐照后氧化的样 品,850 ℃ 高温的退火效应不足以使点缺陷完全回复.

关键词: 球床模块式高温气冷堆, 核级石墨, 离子辐照, 氧化, 点缺陷 **PACS**: 81.05.uf, 28.50.Hw, 61.72.J-, 81.65.Mg

#### 1 引 言

第四代核能系统 (Gen IV) 与当前世界主流的 水冷堆核电站相比,具有更好的经济性和安全性, 符合人们对未来能源的要求,是当今世界核工业发 展的热点. 高温气冷堆是第四代核能系统的其中一 种堆型.在我国,具有完全自主知识产权的球床模 块式高温气冷堆 (HTR-PM) 示范工程即将建成和

© 2019 中国物理学会 Chinese Physical Society

**DOI:** 10.7498/aps.68.20190371

并网发电.HTR-PM 具有出口温度高、工业用途 广、建设运行成本低、经济性好、固有安全性强、核 燃料循环灵活性、放射性产生量小的优点, 商业应 用前景广阔.

核级石墨是 HTR-PM 示范工程所采用的一种 关键堆用材料. 核级石墨是化学纯度高、各向异性 度低、石墨化程度(即具有完美晶体结构的石墨所 占的比例)高的石墨. 核级石墨由于与核燃料和金 属材料的相容性较好,可作为燃料元件基体材料;

<sup>\*</sup> 国家科技重大专项(批准号: ZX069)资助的课题.

<sup>†</sup> 通信作者. E-mail: lvss@bnu.edu.cn

<sup>‡</sup> 通信作者. E-mail: zcli@tsinghua.edu.cn

机械强度好, 热稳定性强, 适合作为堆内的结构材料; 碳元素核性能优异, 中子慢化能力强, 中子吸收截面小, 因而可作为中子慢化剂和中子反射层材料; 热容量大, 热惯性大, 为事故条件下实行校正措施提供了更充足的时间, 提升了 HTR-PM 安全性<sup>[1-3]</sup>.

作为 HTR-PM 示范工程的关键材料,核级石 墨的性能直接影响反应堆的安全运行.反应堆堆内 环境是高温、强中子辐照的环境,中子辐照对材料 造成损伤,同时,气冷堆一回路冷却剂气体中含有 的氧化性杂质可与石墨发生氧化反应.辐照和氧化 的共同作用导致石墨结构的改变和性能的劣化,因 此研究核级石墨缺陷演化行为受辐照和氧化的影 响对于反应堆安全具有重要意义.

对核级石墨辐照行为和氧化行为的研究,国内 外取得了一些进展.在辐照方面,通过以往石墨堆 运行经验的积累,中子辐照引起石墨的结构性能变 化已经有了比较全面的研究结果<sup>[4,5]</sup>.在辐照损伤 程度以及石墨抗辐照性能的评价方面,Zhai等<sup>[6]</sup> 和Zeng等<sup>[7]</sup>系统研究了石墨的拉曼光谱受重离子 辐照的影响,付晓刚等<sup>[8]</sup>提出石墨气孔形貌变化可 作为石墨辐照性能的评价方法,Burchell等<sup>[9]</sup>提出 电阻率可作为研究石墨在辐照和退火后的缺陷演 化的指标.尽管辐照损伤的机理基本确认为辐照产 生的点缺陷(间隙原子和空位),结构性能的变化源 自点缺陷的移动、聚合、复合等演化行为<sup>[10]</sup>,对石 墨中缺陷的模型也有一些讨论<sup>[11]</sup>,但对原子尺度 上石墨缺陷演化的研究还不充分.

在氧化方面,核级石墨孔隙结构<sup>[12]</sup>和化学成 分<sup>[13]</sup>的复杂性对氧化行为有很大的影响,使得不 同牌号石墨的氧化行为有所差别.对于气体流速<sup>[14]</sup> 及温度<sup>[15,16]</sup>等影响石墨氧化的外部因素,在实验 和模拟上已有很多研究.王鹏和于溯源<sup>[17]</sup>总结了 核级石墨氧化的化学动力学模型、失重率影响因子 模型以及模拟计算模型,建立了一种综合考虑这些 因素的影响的石墨氧化模型.在各种事故条件下的 氧化行为也得到了关注和研究,如郑艳华和石磊<sup>[18]</sup>、 徐伟等<sup>[19]</sup>研究了不同事故下燃料元件基体石墨的 腐蚀对反应堆安全的影响.

反应堆的堆内环境是中子辐照和氧化同时发生的环境,二者对石墨性能的协同作用还尚未定论.如 Richards 等<sup>[20]</sup>测试了 H-451 石墨在堆内的水蒸汽腐蚀,发现水蒸气的辐照裂解和中子对石墨

结构造成的破坏增强了石墨的腐蚀. Liu 等<sup>[21]</sup> 计算 模拟了氧气在核级石墨表面和缺陷点位的吸附,认 为辐照产生的缺陷促进氧的吸附和氧化反应. 而 Vavilin 和 Chernikov<sup>[22]</sup> 用中子辐照过的 ZOPG 石墨进行研究,观察到辐照过的样品的腐蚀速率约 为未辐照样品的一半. 因而,为了更准确地预测核 级石墨在反应堆内的行为,有必要对辐照和氧化二者 共同作用下核级石墨中缺陷的演化进行深入研究.

由于中子辐照耗时太长、费用昂贵,且辐照后的样品被中子活化产生放射性,难以进行后续处理和表征,因而本文使用离子辐照来实现不同程度的辐照损伤.本文设计不同的离子辐照和氧化实验,结合多种表征手段,揭示其对石墨中点缺陷演化的影响规律.

#### 2 实验方法

本文研究的对象是日本东洋炭素公司生产的 IG-110 核级石墨. IG-110 核级石墨是一种石油焦 石墨,在 HTR-PM 示范工程中用作堆芯结构材料 和中子反射层材料. 离子辐照和氧化实验的样品 是 IG-110 机械切割成 9 mm × 9 mm × 1.5 mm 的正方形薄片,表面未抛光,每片质量为 0.211— 0.219 g. 对 IG-110 石墨样品进行一系列不同顺 序、不同条件的离子辐照和氧化的实验,分别为仅 辐照、仅氧化、辐照后氧化以及氧化后辐照.

#### 2.1 离子辐照和氧化条件

选择 He<sup>+</sup>离子进行离子辐照. He 具有很好的 化学惰性,不会与石墨产生反应,造成辐照损伤之 外的其他破坏.离子辐照实验在 BNU-400 kV 离 子注入机上进行.离子辐照使用 He<sup>+</sup>离子能量为 190 keV.由 SRIM2008 软件<sup>[23]</sup>模拟的结果 (如图 1 所示)可知,190 keV 的 He<sup>+</sup>在 IG-110 石墨中造成 最大辐照损伤的深度约为表面以下 950 nm 处,造 成辐照损伤的深度不超过 1200 nm.辐照在室温下 进行,采用注量 1 × 10<sup>15</sup>,5 × 10<sup>15</sup>,1 × 10<sup>16</sup>和 1 × 10<sup>17</sup> cm<sup>-2</sup>模拟不同程度的辐照损伤.辐照损伤的 程度由原子平均离位 (dpa) 表示,经计算上述 4 个 注量造成的辐照损伤分别为 0.029, 0.14, 0.29和 2.9 dpa.

氧化实验采用的氧化气体为 20% 的  $O_2$  和 80% 的 He 的混合气体,模拟大气中的氧气浓度.氧

化温度为 850 ℃,氧化时间为 10, 15, 20 和 25 min. 本文选择 850 ℃ 为氧化温度,此时氧化速率较高, 反应受边界层控制机制支配,氧气不能扩散深入石 墨,因而氧化只发生在石墨最表面,内部的石墨处 于高温环境中,点缺陷的行为主要受氧化时伴随的 高温的影响<sup>[16,24]</sup>.

在辐照后氧化和氧化后辐照的实验中,为了分 别研究辐照剂量和氧化时间对石墨中的缺陷的影 响,分别对辐照和氧化的条件进行控制. 辐照后氧 化的实验可分为两组: 一组是先进行 1 × 10<sup>17</sup> cm<sup>-2</sup> He<sup>+</sup>辐照,再分别氧化 15 和 25 min; 另一组是先进 行 1 × 10<sup>15</sup>, 5 × 10<sup>15</sup>, 1 × 10<sup>16</sup> 和 1 × 10<sup>17</sup> cm<sup>-2</sup> He<sup>+</sup>辐照,再氧化 15 min. 氧化后辐照实验可分为 两组: 一组是先氧化 15 min,再进行 1 × 10<sup>15</sup>, 5 × 10<sup>15</sup>, 1 × 10<sup>16</sup> 和 1 × 10<sup>17</sup> cm<sup>-2</sup> He<sup>+</sup>辐照; 另一组 是 先 氧 化 15 和 25 min,再进行 1 × 10<sup>17</sup> cm<sup>-2</sup> He<sup>+</sup>辐照.



图 1 SRIM 软件模拟不同注量的 190 keV He<sup>+</sup>辐照后 IG-110 核级石墨中缺陷数量的深度分布

Fig. 1. SRIM simulation of the depth profiling of defects in IG-110 nuclear grade graphite after different fluences of 190 keV He<sup>+</sup> irradiation.

#### 2.2 表征方法

采用扫描电子显微镜 (scanning electron micro scopy, SEM)和 X 射线 衍射 (X-ray diffraction, XRD)表征样品的表面形貌、孔隙尺寸和晶体结 构. SEM 是常用的形貌观察手段,可观察石墨表面 的孔隙形状、分布和尺寸.而 XRD 衍射可测量石 墨晶体各晶面的布拉格衍射峰,从而判断石墨的晶 体结构. SEM 观察在 JEOL-JSM 7001F 型扫描电 子显微镜上进行, XRD 测试在 D/max-2500/PC 型多晶 X 射线衍射仪上进行.考虑到粒子辐照影响的深度较浅, XRD 测试采用小角掠入射 X 射线衍射.

拉曼光谱可用于测量样品的石墨化程度. 石墨的拉曼光谱中显示 4 个强的拉曼特征峰, 即 G 峰、 D 峰以及其二阶散射峰 G\*峰和 D\*峰. 在 1580 cm<sup>-1</sup>处的 G 峰为石墨晶体的 *E*<sub>2g</sub> 光学模, 在 1350 cm<sup>-1</sup>处的 D 峰为需要缺陷参与的双共振拉曼散射过程<sup>[25]</sup>. D 峰和 G 峰的强度比 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub> 与缺陷密度有关, 通常认为缺陷密度较小时 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub> 与"缺陷的平均距离"的平方成反比, 与晶粒尺寸 (晶粒边缘视作缺陷)成正比, 而缺陷密度较大时 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub> 与"缺陷的平均距离"成正比; 比例系数与拉曼测试的激光 波长有关<sup>[26]</sup>. 因此, 可以由 D 峰与 G 峰的强度比(*I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub>)的大小判断石墨化程度的高低和缺陷的数量.本文采用 HORIBA Jobin Yvon HR800 拉曼光谱仪测量石墨的拉曼光谱.

正电子湮灭多普勒展宽 (positron annihilation Doppler broadening, PADB) 是一种将正电子注 入材料表面,通过测量正电子与材料中的电子湮灭 后产生的光子的能量,从而分析材料中缺陷种类和 密度的测试方法. PADB 测试已被证明能够用于 有效研究石墨中的缺陷[27,28]. 正电子与静止电子湮 灭释放出的光子的能量为 511 keV, 但由于材料中 的电子具有动量,受多普勒效应的影响,释放出的 光子能量发生改变,在能谱图上的峰位产生偏移. 正电子与动量较小的价电子湮灭后,光子能量的偏 移小;正电子与动量较大的内层电子湮灭后,光子 能量的偏移大.多普勒展宽的程度可以用 S参数 和 W参数表示<sup>[29]</sup>. S参数代表能量偏移较小的光 子,即由正电子与动量较小的价电子湮灭释放的那 部分光子,因此 S参数对材料中的空位型缺陷敏 感. W参数代表能量偏移较大的光子,即由正电子 与动量较大的内层电子湮灭释放的那部分光子.正 电子注入材料的深度与正电子能量和材料密度有 关,统计不同能量的正电子与材料发生湮灭所释放 的光子能量,可知材料缺陷随深度的分布.本文的 PADB测试由可变能量正电子束装置<sup>[30]</sup>完成,该 装置产生的正电子束的能量可以在 0.1—25 keV 的范围内调整, 25 keV的正电子在石墨中的平均 注入深度为 4.17 µm, 涵盖了本工作 190 keV 的 He+离子辐照造成损伤的深度范围.

3 实验结果与分析

#### 3.1 辐照和氧化对晶体结构、形貌的影响

仅辐照的样品和仅氧化的样品的 XRD 图谱 如图 2 所示.由于 2θ = 26.4°左右的石墨 (002) 衍 射峰比其他峰强得多,所以为了比较大多数衍射峰 的峰形,图 2 的横坐标 2θ 从 40°开始.仅辐照 (Irr.) 的样品的 XRD 图谱表明,在本文的离子辐照条件 下的剂量不影响石墨的晶体结构. 仅氧化 (Ox.) 的 样品的 XRD 图谱表明,石墨的晶体结构也没有因 氧化而发生改变.



图 2 样品的 XRD 图谱 (a) 仅辐照的样品; (b) 仅氧化的样品

Fig. 2. XRD patterns of the samples: (a) Irr. samples; (b) Ox. samples.

仅氧化的样品的 SEM 形貌如图 3 所示. 由图 3 可见,氧化后孔径尺寸略微增大. 统计未氧化样品和氧化 10, 15, 20 和 25 min 的样品表面孔径,得到未氧化样品和氧化 10, 15, 20 和 25 min 后 IG-110 核级石墨平均孔径分别为 7.5, 8.8, 8.0, 8.1 和 8.1 µm. 由 SEM 观察到的孔径变化可以确认, 850 ℃

氧化之后 IG-110 石墨表面孔径比未氧化时略有增 大,而不同时间氧化后 IG-110 石墨的孔径比较接 近,说明 20% 的 O<sub>2</sub> 在 850 ℃ 温度下与 IG-110 石墨含有的填充颗粒和粘结剂相组分发生的氧化 反应比较均匀,没有引起孔隙结构的显著变化,且 反应受边界层控制机制的支配,氧化只发生在表 面,因而氧化后样品形貌与未氧化样品区别较明 显,而氧化不同时间之后的样品形貌区别不明显.

#### 3.2 辐照和氧化对点缺陷和石墨化程度的 影响

仅辐照的样品的拉曼光谱和 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub> 的变化如 图 4(a) 和图 5(a) 所示. 由图 4(a) 可见, 未辐照样 品 D 峰很弱, 辐照后的样品则出现了明显的 D 峰, 并且 D 峰和 G 峰在高剂量辐照后明显展宽. Zhai 等<sup>[6]</sup> 也观察到离子辐照前石墨 D 峰很微弱, 而辐照后 D 峰随注量增大而有所增强. Lucchese 等<sup>[31]</sup> 认为 D 峰的展宽代表非晶结构的形成, 但在 本工作的 XRD 测试中没有观察到非晶结构的形 成, 可能是由于拉曼光谱比 X 射线衍射对于石墨 非晶结构更敏感.

图 5(a) 横坐标为辐照后用 SRIM2008 模拟计 算得到的辐照损伤 (dpa) 的对数值, 三条折线最左 侧的点代表的都是未辐照的样品.由图 5(a)可见, 随着辐照剂量增加, I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>高于未处理样品, 且先 增大后减小,点缺陷浓度先增大后降低.跟据 Lucchese 等<sup>[31]</sup>的研究, 围绕但不包括缺陷的环形 区域("活化区域")对D峰强度的贡献比缺陷区域 更大. 在低剂量下, 辐照产生的点缺陷浓度随着辐 照剂量增大而增大,石墨化程度随之降低.而在高 剂量下,"缺陷的平均距离"因为缺陷的增多而减 少,缺陷的影响区域发生重叠,导致这种"活化区 域"反而减少,因而高剂量下 ID/IG 随石墨缺陷密 度的增高而降低. 另一方面, 由于间隙原子的扩散 可以导致原本孤立的间隙原子聚集成了间隙原子 链和间隙原子环,最后形成新的石墨原子层,而原 本孤立的空位也能形成空位簇<sup>[32]</sup>,这种效应也对 高辐照剂量下 I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub> 的降低有所贡献.

仅氧化的样品的拉曼光谱和 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub> 的变化如 图 4(b) 和图 5(b) 所示.由图 4(b) 和图 5(b) 可见, 氧化能够使 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub> 降低到低于未处理样品的水平. 这种现象可归因于氧化时的高温带来的退火效应, 即高温下缺陷容易移动,点缺陷发生复合并消失<sup>[28]</sup>.



图 3 样品的尺寸和形貌 (a) 未处理样品尺寸; (b) 未处理样品的 SEM 形貌; 氧化 (c) 10, (d) 15, (e) 20, (f) 25 min 的样品的 SEM 形貌

Fig. 3. Size and morphology of the samples: (a) Size of untreated sample; SEM morphology of (b) untreated sample; SEM morphology and of Ox. samples that were oxidized for (c) 10, (d) 15, (e) 20, (f) 25 min.

未处理样品中也存在一定的点缺陷,因而高温氧化的退火效应使得氧化后石墨点缺陷浓度低于未处理样品.另外,该结果也说明,20%的O<sub>2</sub>在850 ℃条件下的氧化对石墨的破坏不体现为增加点缺陷.



图 4 样品的拉曼光谱 (a) 仅辐照的样品; (b) 仅氧化的 样品

Fig. 4. Raman spectra of the samples: (a) Irr. samples; (b) Ox. samples.

对于进行不同剂量的离子辐照后再氧化相同时间的样品,由图 5(a)可见, *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub>处于与未处理



图 5  $I_D/I_G$ 的变化 (a) 仅辐照的样品、辐照后氧化的样品和氧化后辐照的样品; (b) 仅氧化的样品的  $I_D/I_G$ Fig. 5. Evolution of  $I_D/I_G$  ratios of the samples: (a) Irr.,

Irr.-Ox., Ox.-Irr. samples; (b) Ox. samples.

样品相当的水平, 甚至略低于未处理样品. 这是因 为离子辐照产生的点缺陷在高温退火效应影响下 发生复合. 注意到图 5(a) 中辐照后氧化的石墨样 品的 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub>高于仅氧化的样品, 说明 850 ℃ 高温 退火效应不能消除所有离子辐照产生的缺陷. 这是 因为辐照产生的点缺陷发生移动和聚集, 形成的一 些较大的缺陷团簇需要比 850 ℃ 更高的温度才能 够回复<sup>[11,28]</sup>.

对于固定氧化时间、氧化后辐照的样品,由 图 5(a)可见,其 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub>与仅辐照样品的 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub>变化 趋势一致,即高于未处理样品,且先增大后减小, 同样表示点缺陷数量的增加以及由此导致的石墨 化程度的下降.结合仅氧化石墨样品与未处理样品 的对比可以推测,首先在高温氧化过程中,退火效 应将点缺陷的数量减少到低于未处理样品的水平. 随后,辐照在石墨中产生缺陷,但由于石墨中缺陷 的初始浓度低于未处理样品,因而在相同剂量的辐 照之后,氧化后辐照的样品的 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub> 略小于仅辐照 的样品.而在辐照剂量最高的条件下,氧化后辐照 样品的 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>G</sub>高于仅辐照样品,可能是由于初始缺 陷较少,因而离子辐照新引入的缺陷造成的"活化 区域"在达到最大之后的减少程度反而不如仅辐照 样品, I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>下降的程度也不如仅辐照的样品.

#### 3.3 点缺陷的演化

仅辐照的样品和仅氧化的样品中不同深度的 S参数如图 6(a) 和图 6(b) 所示.为了图片显示清 楚,图中仅标出了未处理样品的 S参数的误差棒, 其他样品的 S参数的误差棒大小与此相近.由 图 6(a) 可见,在仅辐照的样品中缺陷数量出现一 个缓峰,其宽度与 SRIM 预测的缺陷分布相符.辐 照剂量越高,S参数也越高,即形成了更高浓度的 缺陷.另一方面,从图 6(b)可知氧化之后 S参数降 低,可以用高温条件下的退火效应解释.图 6(c) 和 图 6(d)显示了平均 S参数 (在 250—1250 nm 的 深度范围内计算,涵盖了缓峰的范围)随辐照剂量 和氧化时间的变化,清楚地显示出辐照会产生缺陷 而氧化减少了点缺陷的规律.



图 6 样品中不同深度的 S参数和平均 S参数随辐照剂量和氧化时间的变化 (a), (c) 仅辐照的样品; (b), (d) 仅氧化的样品 Fig. 6. Profiles of S-parameter and trends of the evolution of S-parameter: (a), (c) Irr. samples; (b), (d) Ox. samples.

平均 S参数和平均 W参数之间的关系如图 7 所示.第一,离子辐照和氧化对点缺陷的演化产生 相反的影响.离子辐照使 S参数增大,使 W参数 减小;氧化使 S参数减小,使 W参数增大.高辐照 剂量样品位于未处理样品的右下方, 仅氧化样品和 辐照后氧化样品位于未处理样品的左上方. 第二, 相同辐照剂量的样品的 S, W参数比较接近, 在图 上分布比较集中, 如黑色圆圈圈出的区域所示, 说 明离子辐照产生点缺陷的量是确定的.第三,对于 所有样品,平均 S参数和平均 W参数之间存在较 好的线性关系,随着辐照剂量的增加或氧化时间的 增加没有发生转折,表明在石墨中只存在一种正电 子敏感的缺陷类型,即 Frenkel 点缺陷的空位 (正 电子对空位型缺陷敏感,对间隙原子不敏感)<sup>[27,28]</sup>. 第四,点缺陷空位可以聚集成空位簇或多空位复合 物,在更高的温度下才能被去除<sup>[9,33]</sup>.因此,对于辐 照后氧化的样品,退火不能使缺陷完全回复,其 S参数和 I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>高于仅氧化的样品,体现在图中即 辐照后氧化样品位于仅氧化样品的右下方.



图 7 在 250—1250 nm 的深度范围内平均 S参数和平 均 W参数之间的关系

Fig. 7. Relationship of the average  $S\!\!-$  and  $W\!\!-\!\mathrm{parameter}$  in 250–1250 nm of all samples.

### 4 结 论

本文对 IG-110 石墨设计了一系列不同顺序、 不同条件的离子辐照实验和氧化实验,包括仅辐 照、仅氧化、辐照后氧化以及氧化后辐照四种顺序, 以研究离子辐照和氧化对 IG-110 石墨中的点缺陷 的影响.离子辐照实验采用 190 keV 的 He<sup>+</sup>离子在 室温下进行辐照,采用 1 × 10<sup>15</sup>, 5 × 10<sup>15</sup>, 1 × 10<sup>16</sup> 和 1 × 10<sup>17</sup> cm<sup>-2</sup> 的注量造成不同程度的辐照 损伤.氧化实验通过 20% 的 O<sub>2</sub> 在 850 ℃下氧化 10, 15, 20 和 25 min. X 射线衍射研究表明,本文 条件下的离子辐照和氧化对 IG-110 核级石墨的晶 型无影响. 拉曼光谱和正电子湮灭多普勒展宽研究 表明,离子辐照和氧化对 IG-110 的石墨化程度的 变化和点缺陷的形成和演化造成相反的影响.离子 辐照在石墨中只产生一种类型的点缺陷,且随着辐 照剂量的增大,石墨化程度先减小后增大,点缺陷 数量先增大后减小,体现了点缺陷在石墨中的移动 和演化.850 ℃氧化时的高温退火效应可使石墨中 原有的点缺陷以及离子辐照产生的点缺陷部分回 复,降低点缺陷数量,提高石墨化程度.因此,氧化 后辐照样品的点缺陷含量低于仅辐照样品,辐照后 氧化样品的点缺陷含量高于仅氧化样品.

#### 参考文献

- [1] Kelly B T 1982 Carbon 20 3
- [2] Zhou Z, Bouwman W G, Schut H, Pappas C 2014 Carbon 69 17
- [3] Marsden B J, Jones A N, Hall G, Treifi M, Mummery P 2016 Structural Materials for Generation IV Nuclear Reactors (1st Ed.) (Cambridge: Woodhead Publishing) pp495–532
- [4] Heijna M C R, de Groot S D, Vreeling J A 2017 J. Nucl. Mater. 492 148
- [5] Haag G 2005 Properties of ATR-2E Graphite and Property Changes due to Fast Neutron Irradiation (Forschungszentrum Jülich GmbH: Juel-4183) pp49-90
- [6] Zhai P F, Liu J, Zeng J, Yao H J, Duan J L, Hou M D, Sun Y M, Ewing R C 2014 *Chin. Phys. B* 23 126105
- [7] Zeng J, Liu J, Zhang S X, Zhai P F, Yao H J, Duan J L, Guo H, Hou M D, Sun Y M 2015 *Chin. Phys. B* 24 086103
- [8] Fu X G, Li Z C, Zhang Z J 2010 Atom. Energ. Sci. Tech. 44
  686 (in Chinese) [付晓刚, 李正操, 张政军 2010 原子能科学技
  术 44 686]
- [9] Burchell T D, Pappano P J, Strizak J P 2011 Carbon 49 3
- [10] Kelly B, Marsden B, Hall K, Martin D, Harper A, Blanchard A 2000 Irradiation Damage in Graphite due to Fast Neutrons in Fission and Fusion Systems (IAEA-Tecdoc-1154) pp45–114
- [11] Tang Z, Hasegawa M, Shimamura T, Nagai T, Chiba T, Kawazoe Y 1999 Phys. Rev. Lett. 82 2532
- [12] Wang P, Yu S Y 2013 Nucl. Power Eng. 2013 46 (in Chinese) [王鹏, 于溯源 2013 核动力工程 2013 46]
- [13] Chi S, Kim G 2008 J. Nucl. Mater. 381 9
- [14] Yan R, Dong Y, Zhou Y, Sun X M, Li Z C 2017 J. Nucl. Sci. Technol. 54 1168
- [15] Wei M H, Sun X M 2013 Atom. Energ. Sci. Technol. 47 1620 (in Chinese) [魏明辉, 孙喜明 2013 原子能科学技术 47 1620]
- [16] Lee J J, Ghosh T K, Loyalka S K 2013 J. Nucl. Mater. 438 77
- [17] Wang P, Yu S Y 2012 Atom. Energ. Sci. Technol. 46 84 (in Chinese) [王鹏, 于溯源 2012 原子能科学技术 46 84]
- [18] Zheng Y H, Shi L 2010 Atom. Energ. Sci. Technol. 44 253 (in Chinese) [郑艳华, 石磊 2010 原子能科学技术 44 253]
- [19] Xu W, Zheng Y H, Shi L 2017 Atom. Energ. Sci. Technol. 51
  694 (in Chinese) [徐伟, 郑艳华, 石磊 2017 原子能科学技术 51
  694]
- [20] Richards M B, Gillespie A G, Hanson D L 1993 In-pile Corrosion of Grade H-451 Graphite by Steam in Modern Developments in Energy, Combustion and Spectroscopy (1st Ed.) (Oxford: Pergamon Press) pp87–94
- [21] Liu J, Dong L, Wang C, Liang T X, Lai W S 2015 Nucl. Instrum. Meth. B 352 160
- [22] Vavilin A I, Chernikov 1992 Atom. Energ. 73 618
- [23] Ziegler J F, Ziegler M D, Biersack J P 2010 Nucl. Instrum. Meth. B 268 1818
- [24] Wang P 2013 Ph. D. Dissertation (Beijing: Tsinghua Univer

sity) pp30-34 (in Chinese) [王鹏 2013 博士学位论文 (北京: 清 华大学) 第30—34页]

- [25] Reich S, Thomsen C 2004 Phil. Trans. R. Soc. Lond. A 362 2271
- [26] Childres I, Jauregui L, Park W, Cao H, Chen Y P 2013 Raman Spectroscopy of Graphene and Related Materials in New Developments in Photon and Materials Research (1st Ed.) (New York: Nova Science Publishers) pp1-20
- [27] Hu Z, Li Z C, Zhou Z, Shi C Q, Schut H, Pappas K 2014 J. Phys. Conf. Ser. 505 012014
- [28] Shi C Q, Schut H, Li Z C 2016 J. Phys. Conf. Ser. 674 012019
- [29] MacKenzie I K, Eady J A, Gingerich R R 1970 Phys. Lett. A

**33** 279

- [30] Schut H 1990 Ph. D. Dissertation (Delft: Delft University of Technology) pp67-102
- [31] Lucchese M M, Stavale F, Martins Ferreira E H, Vilani C, Moutinho M V O, Capaz R B, Achete C A, Jorio A 2010 *Carbon* 48 1592
- [32] Xu S J, Kang F Y 2010 Carbon and Graphite Materials in Nuclear Engineering (1st Ed.) pp140-143 (in Chinese) [徐世 江,康飞宇 2010 核工程中的炭和石墨材料 (北京:清华大学出 版社) (第1版) 第140—143页]
- [33] Latham C D, Heggie M I, Alatalo M, Oberg S, Briddon P R 2013 J. Phys. Conden. Matter 25 135403

### Effects of ion irradiation and oxidation on point defects in IG-110 nuclear grade graphite<sup>\*</sup>

Li Ming-Yang<sup>1)</sup> Zhang Lei-Min<sup>2)</sup> Lv Shasha<sup>3)†</sup> Li Zheng-Cao<sup>4)‡</sup>

1) (Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

2) (China North Nuclear Fuel Co., Ltd., Baotou 014035, China)

3) (College of Nuclear Science and Technology, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

4) (Key Laboratory of Advanced Materials (MOE), School of Materials Science and Engineering,

Tsinghua University, Beijing 100084, China)

(Received 15 March 2019; revised manuscript received 12 April 2019)

#### Abstract

Nuclear grade graphite is a kind of key material in the high temperature gas-cooled reactor pebble-bed module (HTR-PM), where nuclear grade graphite acts as the fuel element matrix material, structural material and neutron reflector. In the reactor, the service environment of nuclear grade graphite suffers high temperature and strong neutron radiation. Both neutron radiation and the oxidation by the oxidizing impurities in HTGR coolant can cause the structure to damage and the properties to deteriorate. Therefore, it is of great significance to study the evolution of defects in nuclear grade graphite for improving the reactor safety. The effects of ion irradiation and oxidation on the point defects in IG-110 graphite are studied in this work. The 190 keV He<sup>+</sup> implantation treatments at room temperature with fluences of  $1 \times 10^{15}$ ,  $5 \times 10^{15}$ ,  $1 \times 10^{16}$  and  $1 \times 10^{17}$  cm<sup>-2</sup> are performed to induce 0.029, 0.14, 0.29 and 2.9 displacements per atom respectively. Oxidation treatments are performed at 850 °C for 10, 15, 20 and 25 min. Different sequences of He<sup>+</sup> ion irradiation and oxidation are performed, which include irradiation only (Irr.), oxidation only (Ox.), irradiation followed by oxidation (Irr.-Ox.), and oxidation followed by irradiation (Ox.-Irr.). Raman spectrum shows that with the increase of ion irradiation dose, the intensity ratio of D peak to G peak  $(I_D/I_G)$  first increases and then decreases, implying that the point defects in graphite are induced by ion irradiation and the point defects evolve as dose increases; the degree of graphitization increases after oxidation, implying that the point defects are recovered by the annealing effect at high temperature, and the point defects decrease after oxidation. This makes Ox.-Irr. samples have a lower point defect content than Irr. samples, and leads Irr.-Ox. samples to possess a higher point defect content than Ox. samples. The positron annihilation Doppler broadening tests reveal that there are only point defects after ion irradiation and oxidation have partially recovered point defects. The ion irradiation and oxidation have opposite effects on the evolution of point defect in graphite. The ion irradiation increases the average S-parameter and reduces the average W-parameter, while oxidation reduces the average Sparameter and increases the average W-parameter. The annealing effect at 850 °C cannot completely recover the point defects in Irr.-Ox. samples.

Keywords: high temperature gas-cooled reactor pebble-bed module, nuclear grade graphite, ion irradiation, oxidation, point defect

**PACS:** 81.05.uf, 28.50.Hw, 61.72.J–, 81.65.Mq

#### **DOI:** 10.7498/aps.68.20190371

- \* Project supported by the National Science and Technology Major Project of the Ministry of Science and Technology of China (Grant No. ZX069).
- † Corresponding author. E-mail: <a href="https://www.edu.cn">https://www.edu.cn</a>

‡ Corresponding author. E-mail: zcli@tsinghua.edu.cn